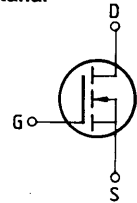


Eckwerte

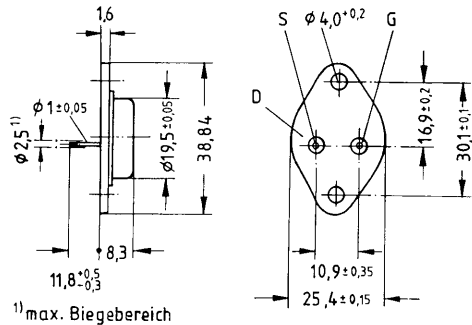
Drain-Source-Spannung $V_{DS} = 600 \text{ V}$
Drain-Gleichstrom $I_D = 7,8 \text{ A}$
Drain-Source-Einschaltwiderstand $R_{DS(on)} = 0,9 \Omega$

N-Kanal



Ausführung SIPMOS, N-Kanal, Anreicherungstyp
Gehäuse Metallgehäuse 3A2 nach DIN 41 872 bzw. nach JEDEC TO 204 AA (TO 3).
 Gewicht: ca. 12 g

Typ	Bestellnummer
BUZ 94	C67078-A1019-A2



Grenzwerte

Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit	Bedingungen
Drain-Source-Spannung	V_{DS}	600	V	
Drain-Gate-Spannung	V_{DGR}	600	V	$R_{GS} = 20 \text{ k}\Omega$
Drain-Gleichstrom	I_D	7,8	A	$T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Drain-Strom, gepulst	I_{Dpuls}	31	A	$T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Gate-Source-Spannung	V_{GS}	± 20	V	
Max. Verlustleistung	P_D	125	W	$T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur- und Lagertemperaturbereich	T_{stg}	$-55 \dots +150$	$^\circ\text{C}$	
Feuchtklasse		C	-	DIN 40040
Prüfklasse		55/150/56	-	DIN IEC 68-1

Wärmewiderstand

Chip – Gehäuse	$R_{th \text{ JC}}$	$\leq 1,0$	K/W
Chip – Umgebung	$R_{th \text{ JA}}$	≤ 35	K/W

Kennwerte

(bei $T_j = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung	Symbol	Kennwerte			Einheit	Bedingungen
		min.	typ.	max.		

Statische Werte

Drain-Source-Durchbruchspannung	$V_{(BR)DSS}$	600	–	–	V	$V_{GS} = 0V$ $I_D = 0,25mA$
Gate-Schwellenspannung	$V_{GS(th)}$	2,1	3,0	4,0		$V_{DS} = V_{GS}$ $I_D = 1mA$
Drain-Reststrom	I_{DSS}	–	20	250	μA	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$ $V_{DS} = 600V$ $V_{GS} = 0V$
Gate-Source-Leckstrom	I_{GSS}	–	10	100	nA	$V_{GS} = 20V$ $V_{DS} = 0V$
Drain-Source-Einschaltwiderstand	$R_{DS(on)}$	–	0,8	0,9	Ω	$V_{GS} = 10V$ $I_D = 5A$

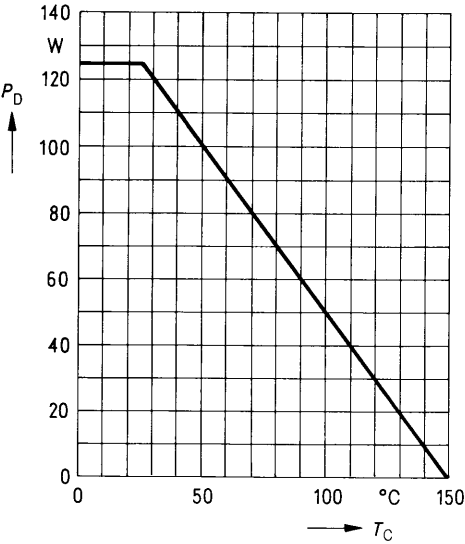
Dynamische Werte

Übertragungssteilheit	g_{fs}	2,7	4,0	–	S	$V_{DS} = 25V$ $I_D = 5A$
Eingangskapazität	C_{iss}	–	3,8	4,9	nF	$V_{DS} = 25V$ $f = 1MHz$
Ausgangskapazität	C_{oss}	–	250	400	pF	
Rückwirkkapazität	C_{rss}	–	100	170		
Einschaltzeit t_{on} ($t_{on} = t_{d(on)} + t_r$)	$t_{d(on)}$	–	50	75	ns	$V_{CC} = 30V$ $I_D = 2,8A$ $V_{GS} = 10V$ $R_{GS} = 50\Omega$
	t_r	–	80	120		
Ausschaltzeit t_{off} ($t_{off} = t_{d(off)} + t_f$)	$t_{d(off)}$	–	330	430		
	t_f	–	110	140		

Inversdiode

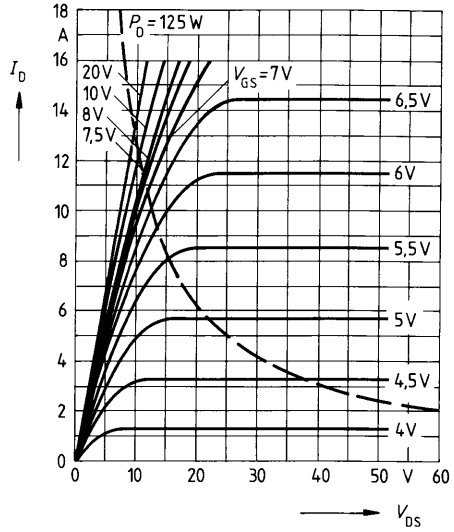
Gleichstrom	I_{DR}	–	–	7,8	A	$T_C = 25^\circ\text{C}$
Gleichstrom, gepulst	I_{DRM}	–	–	31		
Durchlaßspannung	V_{SD}	–	1,3	1,7	V	$I_F = 2 \times I_{DR}$ $V_{GS} = 0V, T_j = 25^\circ\text{C}$
Sperrverzögerungszeit	t_{rr}	–	1,2	–	μs	$T_j = 25^\circ\text{C}$
Sperrverzögerungsladung	Q_{rr}	–	12	–	μC	$I_F = I_{DR}$ $d_{F/dt} = 100A/\mu s$ $V_R = 100V$

Verlustleistung $P_D = f(T_C)$



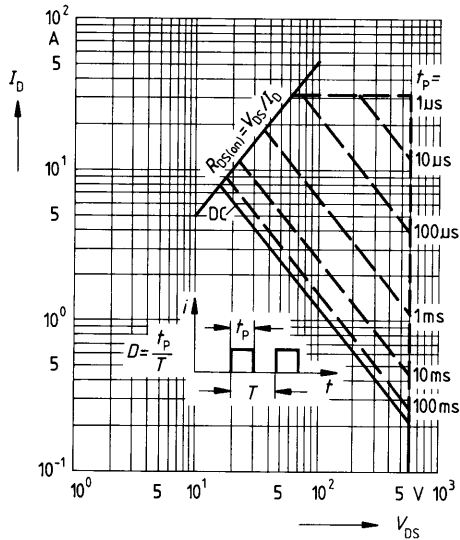
Typ. Ausgangscharakteristik $I_D = f(V_{DS})$

Parameter: 80 μ s-Puls-Test,
 $T_j = 25^\circ\text{C}$



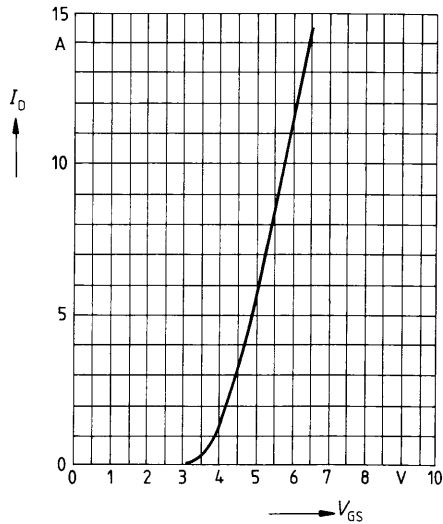
Zul. Betriebsbereich $I_D = f(V_{DS})$

Parameter: $D = 0,01$, $T_C = 25^\circ\text{C}$



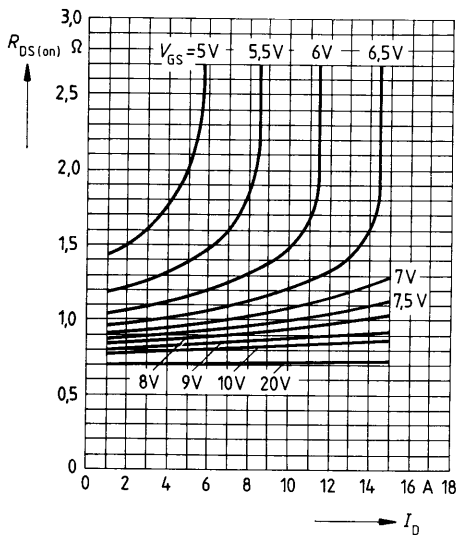
Typ. Übertragungscharakteristik $I_D = f(V_{GS})$

Parameter: 80 μ s-Puls-Test,
 $V_{DS} = 25\text{V}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$



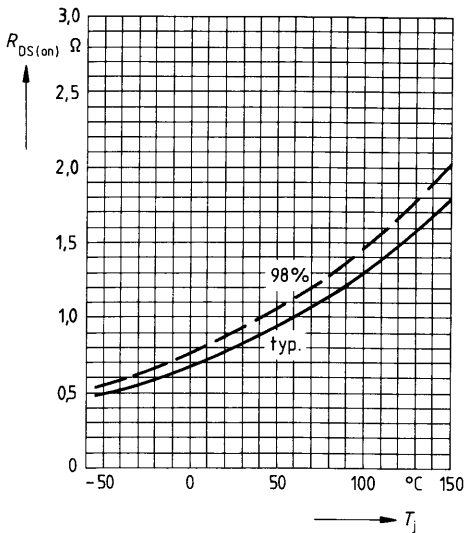
Typ. Einschaltwiderstand $R_{DS(on)} = f(I_D)$

Parameter: $V_{GS}; T_j = 25^\circ\text{C}$



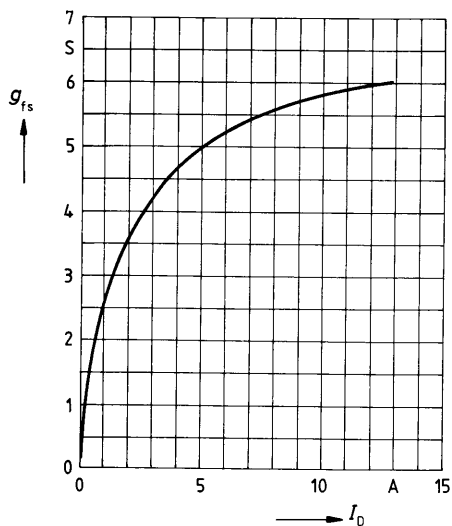
Einschaltwiderstand $R_{DS(on)} = f(T_j)$

Parameter: $I_D = 5\text{A}, V_{GS} = 10\text{V}$
(Streubereich)



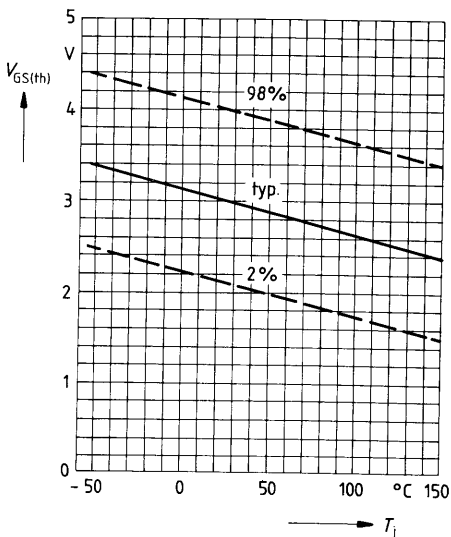
Typ. Übertragungsteilheit $g_{fs} = f(I_D)$

Parameter: 80 μs -Puls-Test,
 $V_{DS} = 25\text{V}, T_j = 25^\circ\text{C}$

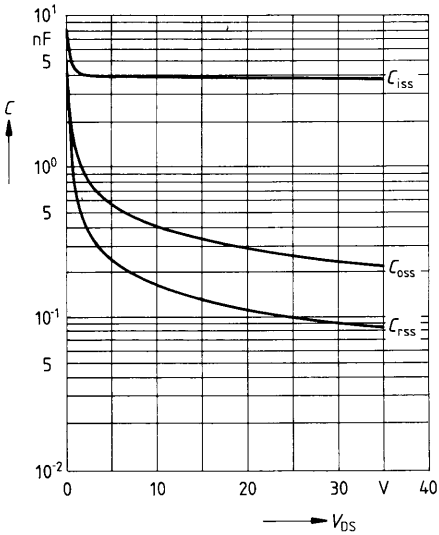


Gate Schwellenspannung $V_{GS(th)} = f(T_j)$

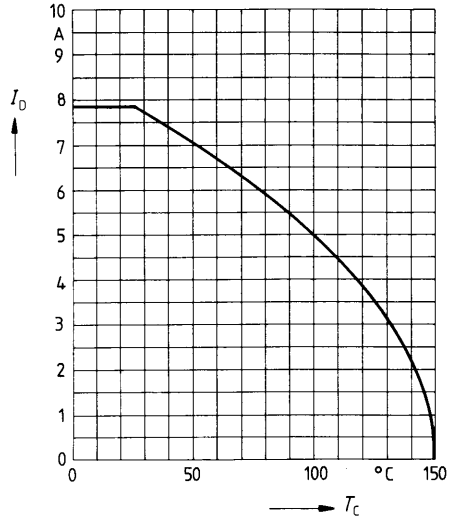
Parameter: $V_{DS} = V_{GS}, I_D = 1\text{mA}$
(Streubereich)



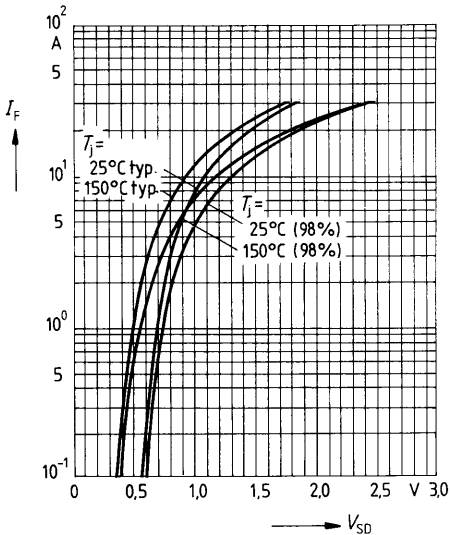
Typ. Kapazitäten $C = f(V_{DS})$
 Parameter: $V_{GS} = 0$, $f = 1\text{MHz}$



Drainstrom $I_D = f(T_C)$
 Parameter: $V_{GS} \geq 10\text{V}$

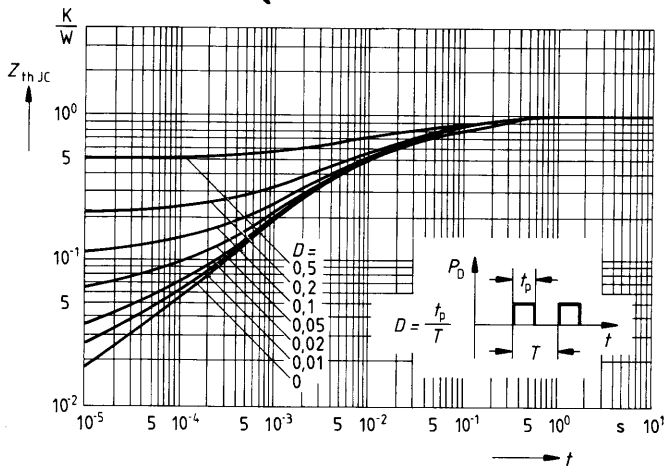


Durchlaßkennlinie Inversdiode $I_F = f(V_{SD})$
 Parameter: $T_j, t_p = 80 \mu\text{s}$
 (Streubereich)



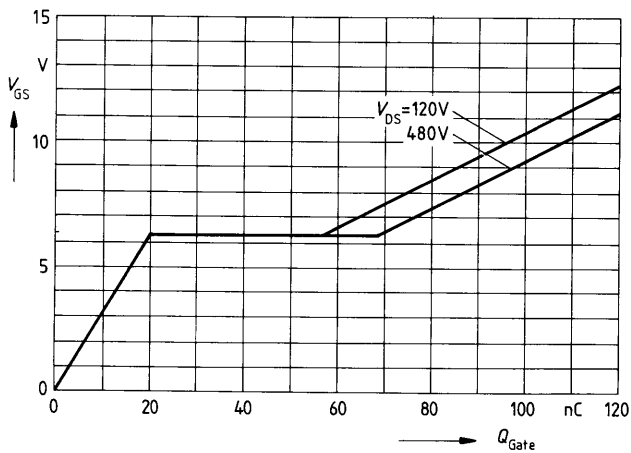
Transienter Wärmewiderstand $Z_{thJC} = f(t)$

Parameter: $D = t_p/T$



Typ. Gateladung $V_{GS} = f(Q_{Gate})$

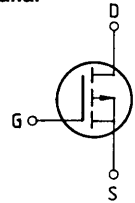
Parameter: $I_{Dpuls} = 11.7A$



Eckwerte

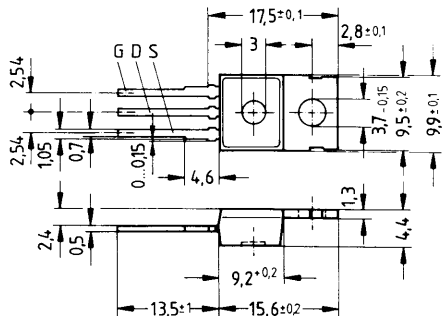
Drain-Source-Spannung $V_{DS} = -50 \text{ V}$
Drain-Gleichstrom $I_D = -7,0 \text{ A}$
Drain-Source-Einschaltwiderstand $R_{DS(on)} = 0,4 \Omega$

P-Kanal



Ausführung SIPMOS, P-Kanal, Anreicherungstyp
Gehäuse Kunststoffgehäuse 14A3 nach DIN 41869 bzw. nach JEDEC TO 220 AB.
 Der Drainanschluß ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.
 Gewicht: ca. 2 g

Typ	Bestellnummer
BUZ 171	C67078-A1450-A2



Grenzwerte

Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit	Bedingungen
Drain-Source-Spannung	V_{DS}	-50	V	
Drain-Gate-Spannung	V_{DGR}	-50	V	$R_{GS} = 20 \text{ k}\Omega$
Drain-Gleichstrom	I_D	-7	A	$T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Drain-Strom, gepulst	$I_{D(puls)}$	-28	A	$T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Gate-Source-Spitzenspannung	V_{gs}	±20	V	nicht periodisch
Max. Verlustleistung	P_D	40	W	$T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur- und Lagertemperaturbereich	T_{stg}	-55... +150	°C	
Feuchtklasse		E	-	DIN 40040
Prüfklasse		55/150/56	-	DIN IEC 68-1

Wärmewiderstand

Chip – Gehäuse	$R_{th JC}$	≤ 3,1	K/W
Chip – Umgebung	$R_{th JA}$	≤ 75	K/W

Kennwerte

(bei $T_j = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung	Symbol	Kennwerte			Einheit	Bedingungen
		min.	typ.	max.		

Statische Werte

Drain-Source-Durchbruchspannung	$V_{(BR)DSS}$	-50	-	-	V	$V_{GS} = 0V$ $I_D = -0,25mA$
Gate-Schwellenspannung	$V_{GS(th)}$	-2,1	-3,0	-4,0		$V_{DS} = V_{GS}$ $I_D = -1mA$
Drain-Reststrom	I_{DSS}	-	-20 -100	-250 -1000	μA	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$ $V_{DS} = -50V$ $V_{GS} = 0V$
Gate-Source-Leckstrom	I_{GSS}	-	-10	-100	nA	$V_{GS} = -10V$ $V_{DS} = 0V$
Drain-Source-Einschaltwiderstand	$R_{DS(on)}$	-	0,3	0,4	Ω	$V_{GS} = -10V$ $I_D = -4,5A$

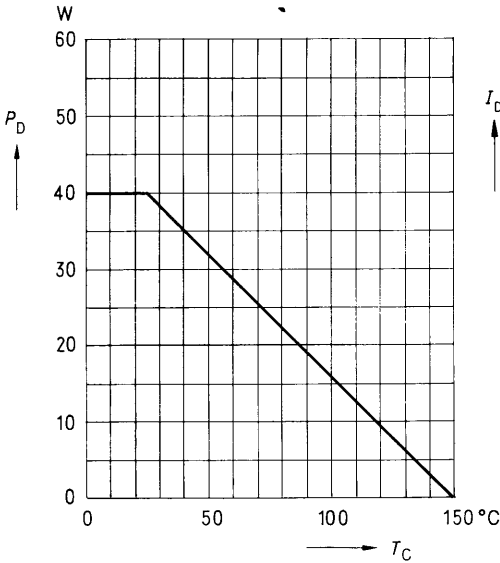
Dynamische Werte

Übertragungsteilheit	g_{fs}	1,5	2,2	-	S	$V_{DS} = -25V$ $I_D = -4,5A$
Eingangskapazität	C_{iss}	-	900	1200	pF	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = -25V$ $f = 1MHz$
Ausgangskapazität	C_{oss}	-	320	500		
Rückwirkkapazität	C_{riss}	-	130	230		
Einschaltzeit t_{on} ($t_{on} = t_{d(on)} + t_r$)	$t_{d(on)}$	-	20	30	ns	$V_{CC} = -30V$ $I_D = -2,9A$ $V_{GS} = -10V$ $R_{GS} = 50\Omega$
	t_r	-	60	95		
Ausschaltzeit t_{off} ($t_{off} = t_{d(off)} + t_f$)	$t_{d(off)}$	-	70	90		
	t_f	-	55	75		

Inversdiode

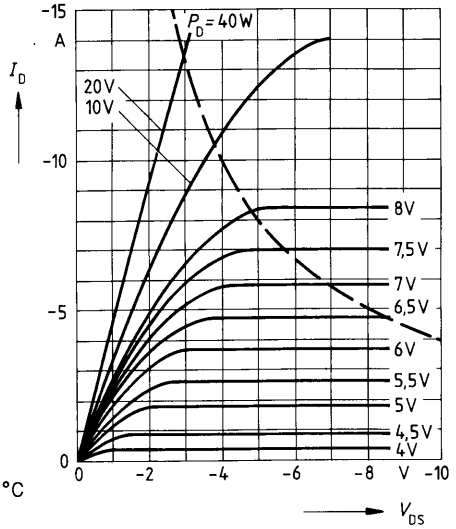
Gleichstrom	I_{DR}	-	-	-7,0	A	$T_C = 25^\circ\text{C}$
Gleichstrom, gepulst	I_{DRM}	-	-	-28		
Durchlaßspannung	V_{SD}	-	-2,0	-2,8	V	$I_F = 2 \times I_{DR}$ $V_{GS} = 0V, T_j = 25^\circ\text{C}$
Sperrverzögerungszeit	t_{rr}	-	90	-	ns	$T_j = 25^\circ\text{C}$
Sperrverzögerungsladung	Q_{rr}	-	0,23	-	μC	$I_F = I_{DR}$ $dI_F/dt = 100A/\mu s$ $V_R = -30V$

Verlustleistung $P_D = f(T_C)$



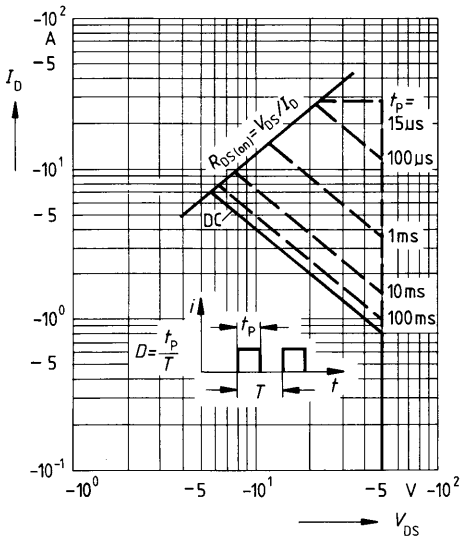
Typ. Ausgangscharakteristik $I_D = f(V_{DS})$

Parameter: 80 μ s-Puls-Test,
 $T_j = 25^\circ\text{C}$



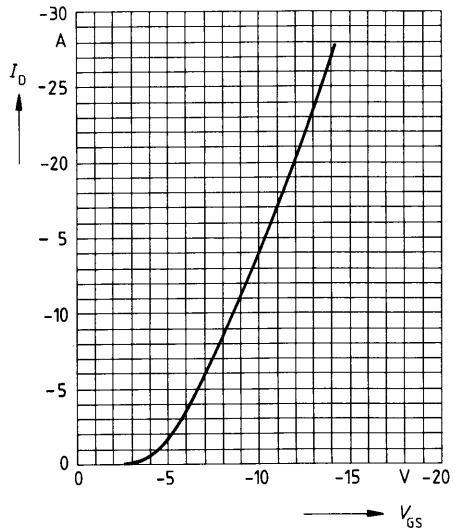
Zul. Betriebsbereich $I_D = f(V_{DS})$

Parameter: $D = 0,01$, $T_C = 25^\circ\text{C}$



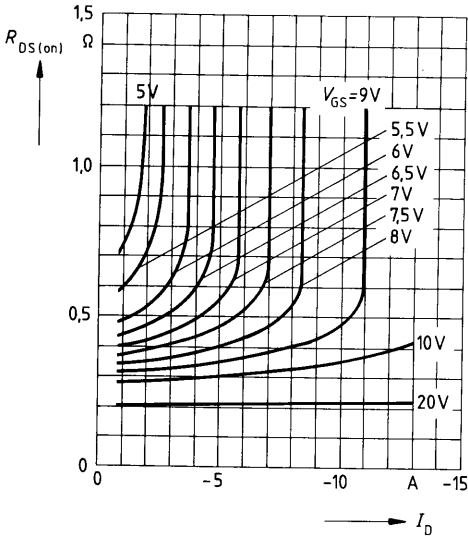
Typ. Übertragungscharakteristik $I_D = f(V_{GS})$

Parameter: 80 μ s-Puls-Test,
 $V_{DS} = -25\text{V}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$



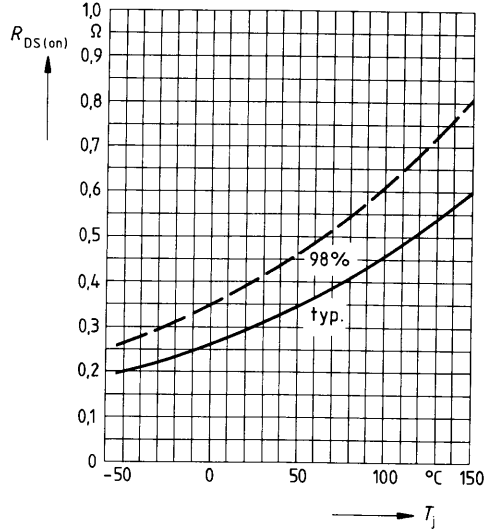
Typ. Einschaltwiderstand $R_{DS(on)} = f(I_D)$

Parameter: $V_{GS}; T_j = 25^\circ\text{C}$



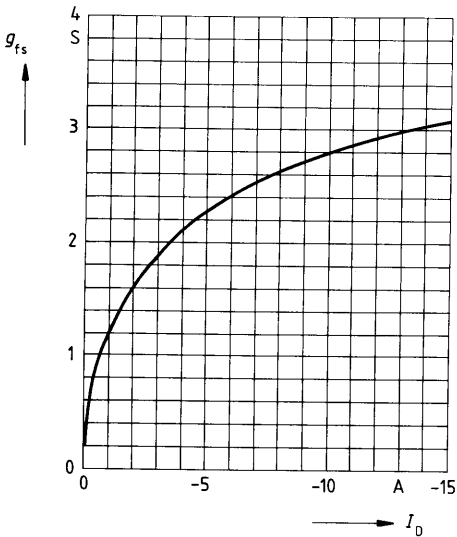
Einschaltwiderstand $R_{DS(on)} = f(T_j)$

Parameter: $I_D = -4.5\text{A}, V_{GS} = -10\text{V}$
(Streubereich)



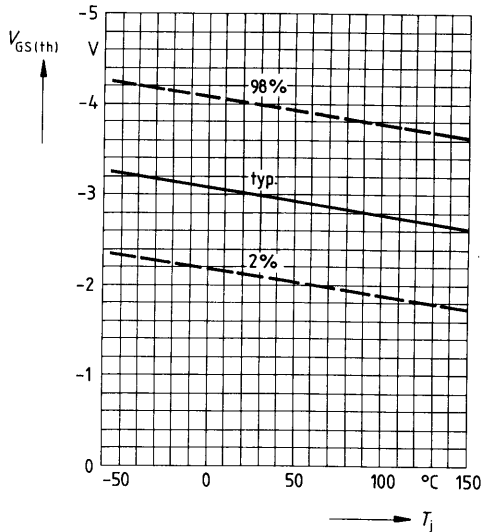
Typ. Übertragungssteilheit $g_{fs} = f(I_D)$

Parameter: 80 μs -Puls-Test,
 $V_{DS} = -25\text{V}, T_j = 25^\circ\text{C}$

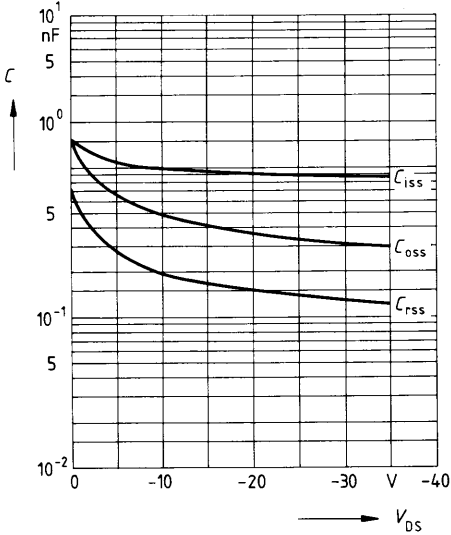


Gate Schwellenspannung $V_{GS(th)} = f(T_j)$

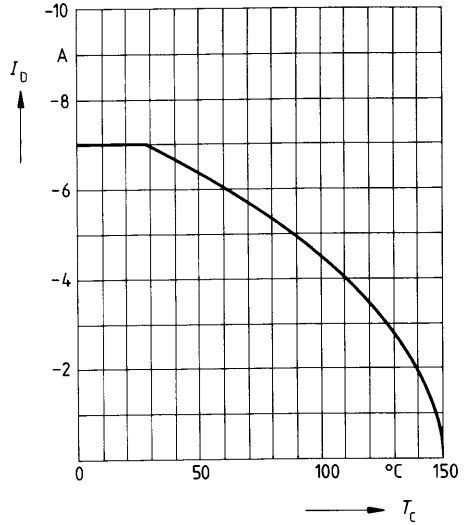
Parameter: $V_{DS} = V_{GS}, I_D = -1\text{mA}$
(Streubereich)



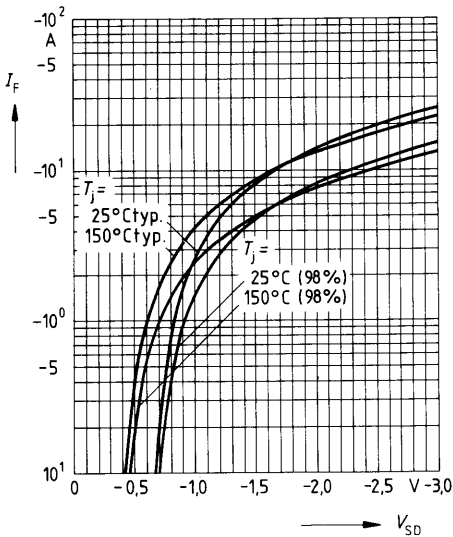
Typ. Kapazitäten $C = f(V_{DS})$
 Parameter: $V_{GS} = 0$, $f = 1\text{MHz}$



Drainstrom $I_D = f(T_C)$
 Parameter: $V_{GS} \geq -10\text{V}$

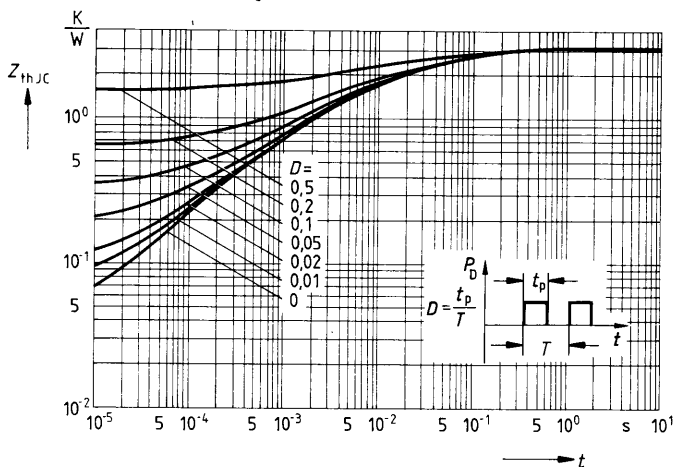


Durchlaßkennlinie Inversdiode $I_F = f(V_{SD})$
 Parameter: $T_j, t_p = 80 \mu\text{s}$
 (Streubereich)



Transienter Wärmewiderstand $Z_{thJC} = f(t)$

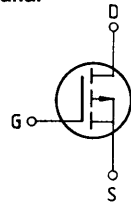
Parameter: $D = t_p/T$



Eckwerte

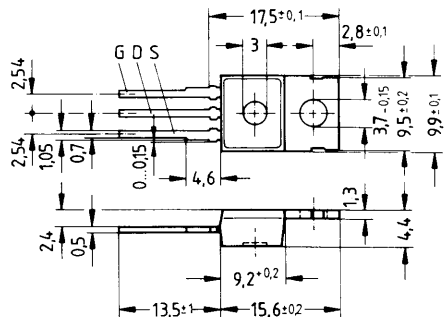
Drain-Source-Spannung $V_{DS} = -100 \text{ V}$
Drain-Gleichstrom $I_D = -5 \text{ A}$
Drain-Source-Einschaltwiderstand $R_{DS(on)} = 0,8 \Omega$

P-Kanal



Ausführung SIPMOS, P-Kanal, Anreicherungstyp
Gehäuse Kunststoffgehäuse 14 A 3 nach DIN 41 869 bzw. nach JEDEC TO 220 AB.
 Der Drainanschluß ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.
 Gewicht: ca. 2 g

Typ	Bestellnummer
BUZ 172	C67078-A1451-A2



Grenzwerte

Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit	Bedingungen
Drain-Source-Spannung	V_{DS}	-100	V	
Drain-Gate-Spannung	V_{DGR}	-100	V	$R_{GS} = 20 \text{ k}\Omega$
Drain-Gleichstrom	I_D	-5	A	$T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Drain-Strom, gepulst	I_{Dpuls}	-20	A	$T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Gate-Source-Spitzenspannung	V_{GS}	±20	V	nicht periodisch
Max. Verlustleistung	P_D	40	W	$T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur- und Lagertemperaturbereich	T_j T_{stg}	-55... +150	°C	
Feuchteklasse	E	-	-	DIN 40040
Prüfklasse	55/150/56	-	-	DIN IEC 68-1

Wärmewiderstand

Chip – Gehäuse	$R_{th JC}$	≤ 3,1	K/W
Chip – Umgebung	$R_{th JA}$	≤ 75	K/W

Kennwerte

(bei $T_j = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung	Symbol	Kennwerte			Einheit	Bedingungen
		min.	typ.	max.		

Statische Werte

Drain-Source-Durchbruchspannung	$V_{(BR)DSS}$	-100	-	-	V	$V_{GS} = 0V$ $I_D = -0,25mA$
Gate-Schwellenspannung	$V_{GS(th)}$	-2,1	-3,0	-4,0		$V_{DS} = V_{GS}$ $I_D = -1mA$
Drain-Reststrom	I_{DSS}	-	-20 -100	-250 -1000	μA	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$ $V_{DS} = -100V$ $V_{GS} = 0V$
Gate-Source-Leckstrom	I_{GSS}	-	-10	-100	nA	$V_{GS} = -10V$ $V_{DS} = 0V$
Drain-Source-Einschaltwiderstand	$R_{DS(on)}$	-	-	0,8	Ω	$V_{GS} = -10V$ $I_D = -3,2A$

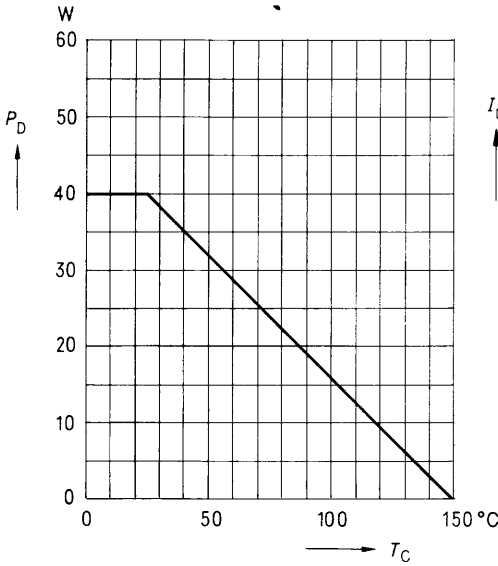
Dynamische Werte

Übertragungsteilheit	g_{ts}	0,9	1,1	-	S	$V_{DS} = -25V$ $I_D = -3,2A$
Eingangskapazität	C_{iss}	-	1000	-	pF	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = -25V$ $f = 1MHz$
Ausgangskapazität	C_{oss}	-	120	-		
Rückwirkkapazität	C_{rss}	-	60	-		
Einschaltzeit t_{on} ($t_{on} = t_{d(on)} + t_r$)	$t_{d(on)}$	-	15	20	ns	$V_{CC} = -30V$ $I_D = -2,8A$ $V_{GS} = -5V$ $R_{GS} = 50\Omega$
	t_r	-	40	60		
Ausschaltzeit t_{off} ($t_{off} = t_{d(off)} + t_f$)	$t_{d(off)}$	-	70	90		
	t_f	-	40	55		

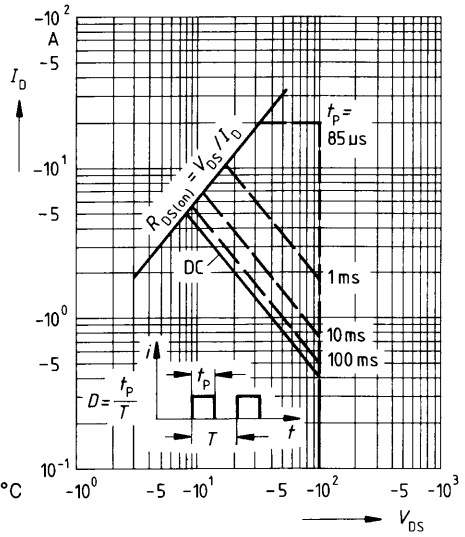
Inversdiode

Gleichstrom	I_{DR}	-	-	-5	A	$T_C = 25^\circ\text{C}$
Gleichstrom, gepulst	I_{DRM}	-	-	-20		
Durchlaßspannung	V_{SD}	-	-	-1,3	V	$I_F = 2 \times I_{DR}$ $V_{GS} = 0V, T_j = 25^\circ\text{C}$
Sperrverzögerungszeit	t_{rr}	-	200	-	μC	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = I_{DR}$ $dI_F/dt = 100A/\mu s$ $V_R = -30V$
Sperrverzögerungsladung	Q_{rr}	-	0,75	-		

Verlustleistung $P_D = f(T_C)$

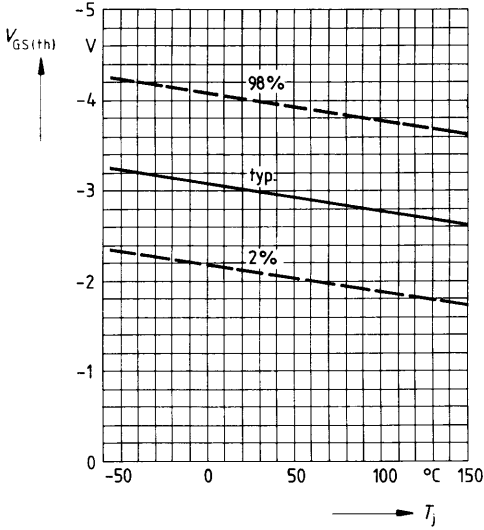


Zul. Betriebsbereich $I_D = f(V_{DS})$
 Parameter: $D = 0,01$, $T_C = 25^\circ\text{C}$



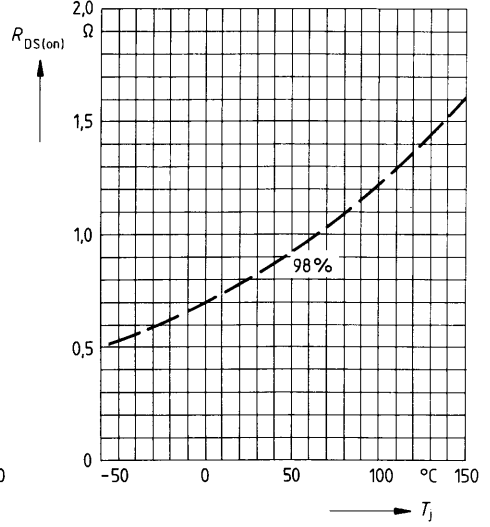
Gate Schwellenspannung $V_{GS(th)} = f(T_j)$

Parameter: $V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = -1\text{mA}$
(Streubereich)

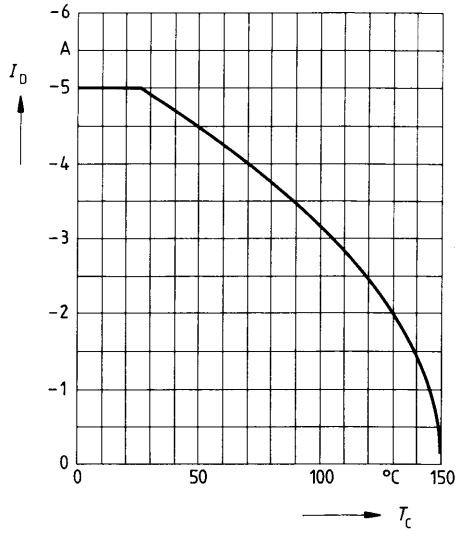


Einschaltwiderstand $R_{DS(on)} = f(T_j)$

Parameter: $I_D = -3,2\text{A}$, $V_{GS} = -10\text{V}$
(Streubereich)

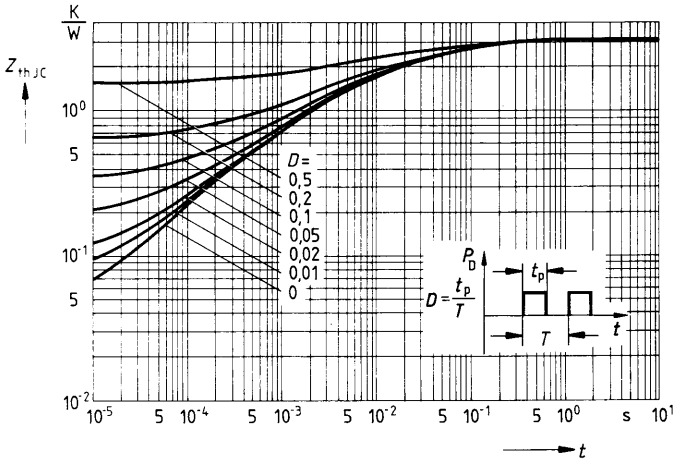


Drainstrom $I_D = f(T_C)$
Parameter: $V_{GS} \geq -10V$



Transienter Wärmewiderstand $Z_{thJC} = f(t)$

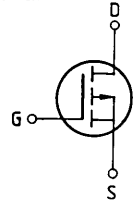
Parameter: $D = t_p/T$



Eckwerte

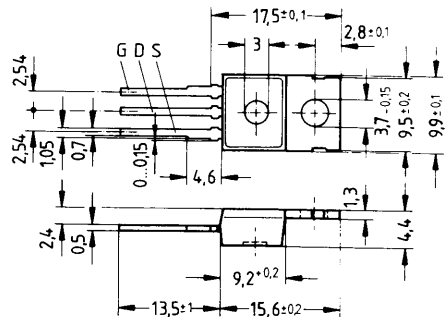
Drain-Source-Spannung $V_{DS} = -200\text{ V}$
 Drain-Gleichstrom $I_D = -3\text{ A}$
 Drain-Source-Einschaltwiderstand $R_{DS(on)} = 2\ \Omega$

P-Kanal



Ausführung SIPMOS, P-Kanal, Anreicherungstyp
Gehäuse Kunststoffgehäuse 14A3 nach DIN 41 869 bzw. nach JEDEC TO 220 AB.
 Der Drainanschluß ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.
 Gewicht: ca. 2 g

Typ	Bestellnummer
BUZ 173	C67078-A1452-A2



Grenzwerte

Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit	Bedingungen
Drain-Source-Spannung	V_{DS}	-200	V	
Drain-Gate-Spannung	V_{DGR}	-200	V	$R_{GS} = 20\text{ k}\Omega$
Drain-Gleichstrom	I_D	-3	A	$T_C = 35\text{ }^\circ\text{C}$
Drain-Strom, gepulst	I_{Dpuls}	-12	A	$T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$
Gate-Source-Spitzenspannung	V_{gs}	±20	V	nicht periodisch
Max. Verlustleistung	P_D	40	W	$T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur- und Lagertemperaturbereich	T_j T_{stg}	-55... +150	°C	
Feuchtklasse		E	-	DIN 40040
Prüfklasse		55/150/56		DIN IEC 68-1

Wärmewiderstand

Chip – Gehäuse	R_{thJC}	≤3,1	K/W
Chip – Umgebung	R_{thJA}	≤75	K/W

Kennwerte

(bei $T_j = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung	Symbol	Kennwerte			Einheit	Bedingungen
		min.	typ.	max.		

Statische Werte

Drain-Source-Durchbruchspannung	$V_{(BR)DSS}$	-200	-	-	V	$V_{GS} = 0V$ $I_D = -0,25mA$
Gate-Schwellenspannung	$V_{GS(th)}$	-2,1	-3,0	-4,0		$V_{DS} = V_{GS}$ $I_D = -1mA$
Drain-Reststrom	I_{DSS}	-	-20 -100	-250 -1000	μA	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$ $V_{DS} = -200V$ $V_{GS} = 0V$
Gate-Source-Leckstrom	I_{GSS}	-	-10	-100	nA	$V_{GS} = -10V$ $V_{DS} = 0V$
Drain-Source-Einschaltwiderstand	$R_{DS(on)}$	-	1,0	2,0	Ω	$V_{GS} = -10V$ $I_D = -2A$

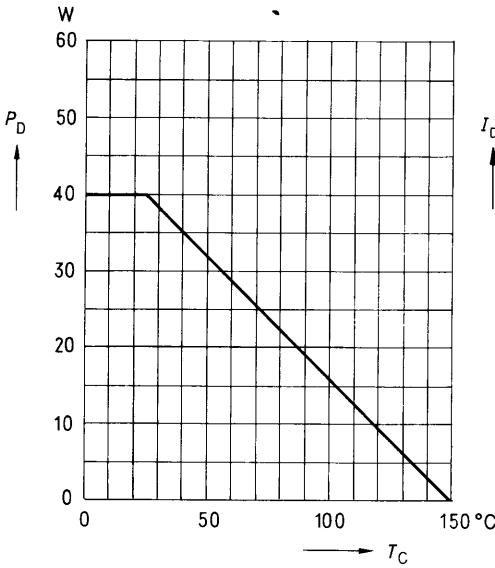
Dynamische Werte

Übertragungssteilheit	g_{fs}	1,1	2,1	-	S	$V_{DS} = -25V$ $I_D = -2A$
Eingangskapazität	C_{iss}	-	1000	1300	pF	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = -25V$ $f = 1MHz$
Ausgangskapazität	C_{oss}	-	130	200		
Rückwirkkapazität	C_{rss}	-	45	80		
Einschaltzeit t_{on} ($t_{on} = t_{d(on)} + t_r$)	$t_{d(on)}$	-	20	30	ns	$V_{CC} = -30V$ $I_D = -2,5A$ $V_{GS} = -5V$ $R_{GS} = 50\Omega$
	t_r	-	60	95		
Ausschaltzeit t_{off} ($t_{off} = t_{d(off)} + t_f$)	$t_{d(off)}$	-	70	90		
	t_f	-	55	75		

Inversdiode

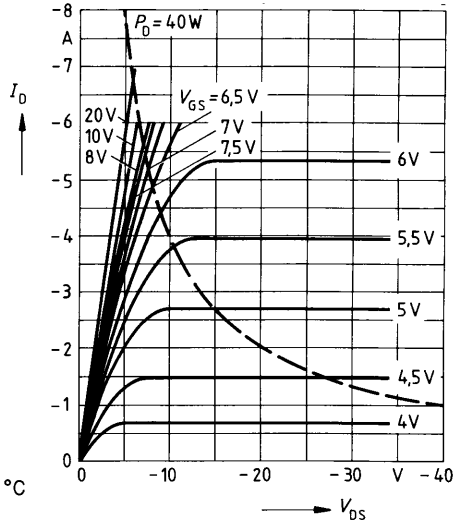
Gleichstrom	I_{DR}	-	-	-3	A	$T_C = 25^\circ\text{C}$
Gleichstrom, gepulst	I_{DRM}	-	-	-12		
Durchlaßspannung	V_{SD}	-	-1	-1,3	V	$I_F = 2 \times I_{DR}$ $V_{GS} = 0V, T_j = 25^\circ\text{C}$
Sperrverzögerungszeit	t_{rr}	-	200	-	μC	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = I_{DR}$ $dI_F/dt = 100A/\mu s$ $V_R = -100V$
Sperrverzögerungsladung	Q_{rr}	-	0,75	-		

Verlustleistung $P_D = f(T_C)$



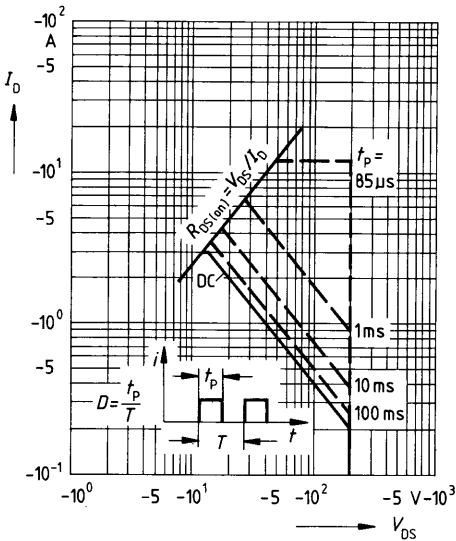
Typ. Ausgangscharakteristik $I_D = f(V_{DS})$

Parameter: 80 μ s-Puls-Test,
 $T_j = 25^\circ\text{C}$



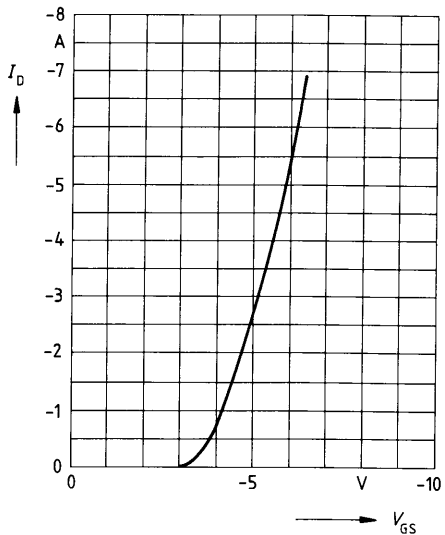
Zul. Betriebsbereich $I_D = f(V_{DS})$

Parameter: $D = 0,01$, $T_C = 25^\circ\text{C}$

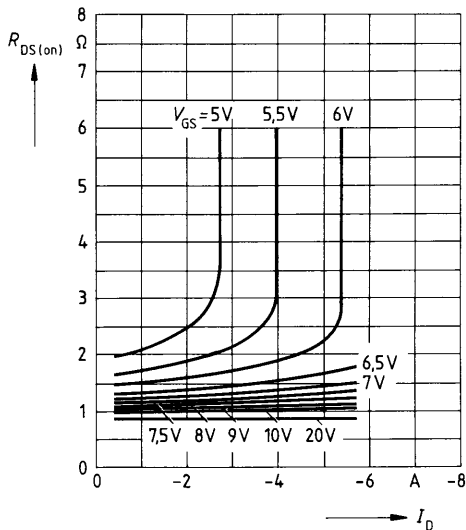


Typ. Übertragungscharakteristik $I_D = f(V_{GS})$

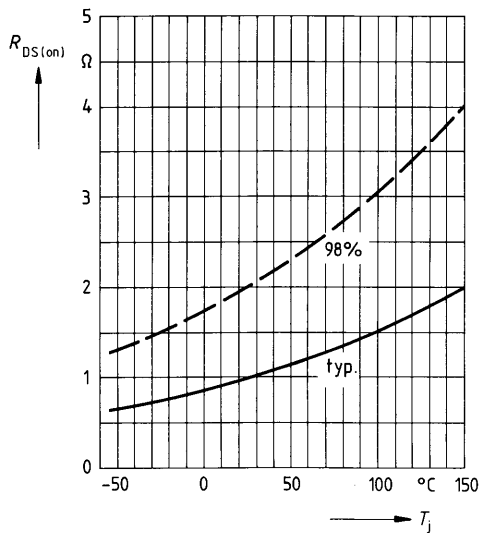
Parameter: 80 μ s-Puls-Test,
 $V_{DS} = -25\text{V}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$



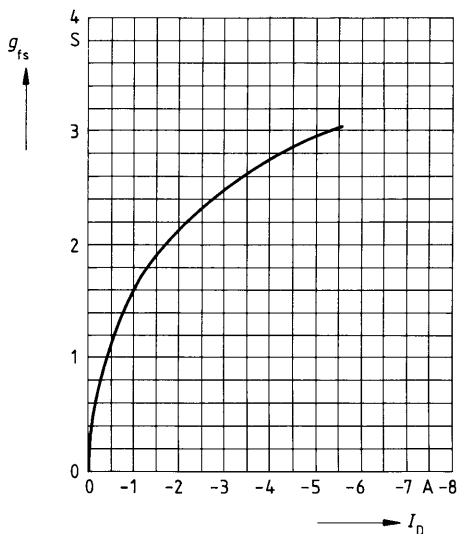
Typ. Einschaltwiderstand $R_{DS(on)} = f(I_D)$
 Parameter: $V_{GS} = T_j = 25^\circ\text{C}$



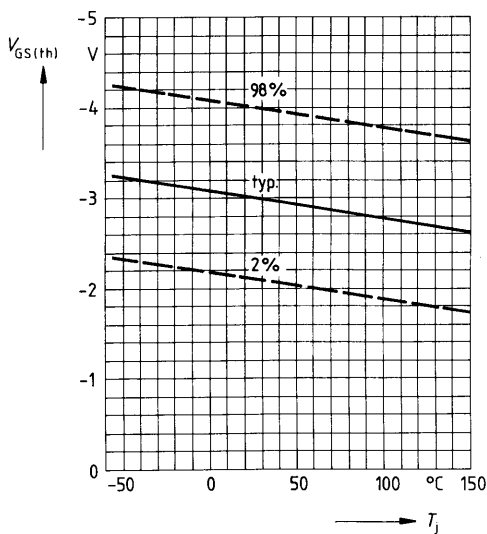
Einschaltwiderstand $R_{DS(on)} = f(T_j)$
 Parameter: $I_D = -2\text{A}, V_{GS} = -10\text{V}$
 (Streubereich)



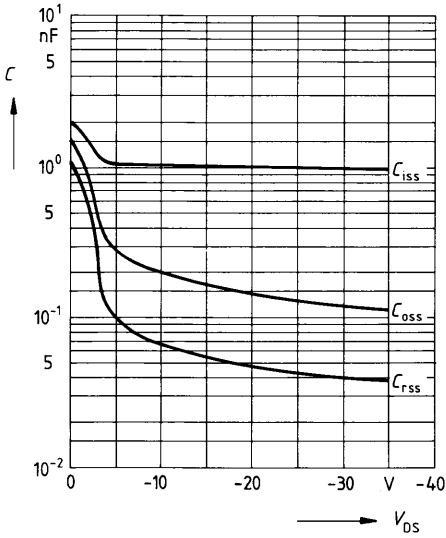
Typ. Übertragungsteilheit $g_{fs} = f(I_D)$
 Parameter: 80 μs -Puls-Test,
 $V_{DS} = -25\text{V}, T_j = 25^\circ\text{C}$



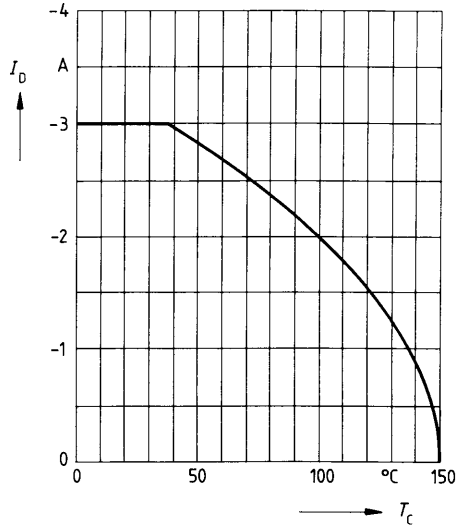
Gate Schwellenspannung $V_{GS(th)} = f(T_j)$
 Parameter: $V_{DS} = V_{GS}, I_D = -1\text{mA}$
 (Streubereich)



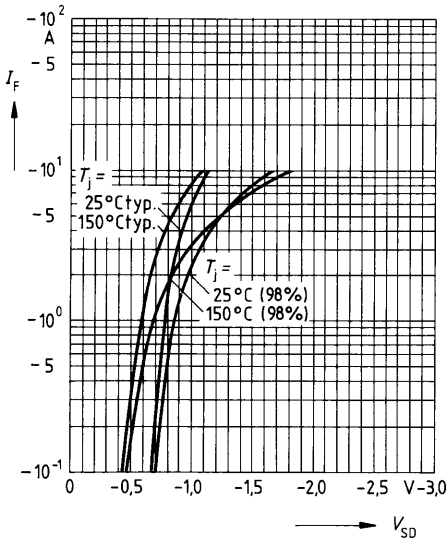
Typ. Kapazitäten $C = f(V_{DS})$
 Parameter: $V_{GS} = 0, f = 1\text{MHz}$



Drainstrom $I_D = f(T_C)$
 Parameter: $V_{GS} \geq -10\text{V}$



Durchlaßkennlinie Inversdiode $I_F = f(V_{SD})$
 Parameter: $\tau_j, t_p = 80 \mu\text{s}$
 (Streubereich)



Transienter Wärmewiderstand $Z_{thJC} = f(t)$

Parameter: $D = t_p/T$

